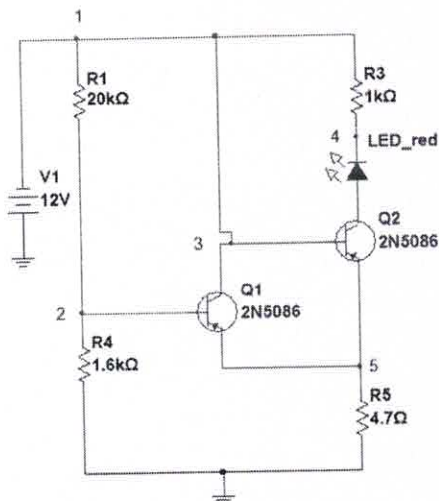


1. Определить внутреннее тепловое сопротивление микросхемы, если при мощности тепловыделения в кристалле микросхемы 2 Вт разность температур корпуса и активной зоны составила 7 °С.
2. Определить поглощение в экране из немагнитного металла за счет вихревых токов, если $f = 10^6$ Гц, $\sigma = 2 \cdot 10^{-7}$ Ом·м, при толщине экрана $t = 0.005$ м.
3. Разработайте электрическую модель с использованием программного комплекса NI Multisim для схемы электрической принципиальной



Для разработанной модели сформируйте справочник характерных неисправностей (СН) для неисправностей вида «обрыв» и «короткое замыкание», и оформите его в виде таблицы:

Вид дефекта	КТ ₁	КТ ₂	...	КТ _n
Исправное состояние	U ₀₁	U ₀₂	...	U _{0n}
D ₁	U ₁₁	U ₁₂	...	U _{1n}
D ₂	U ₂₁	U ₂₂	...	U _{2n}
...				
D _m	U _{m1}	U _{m1}	...	U _{mn}

где КТ – контрольная точка, D – неисправность, m – общее число возможных неисправностей, n – общее число контрольных точек, U_{ij} – значение напряжения для i-ой неисправности в j-ой контрольной точке.

Ответьте на вопрос: какой неисправности соответствует следующая комбинация напряжений?

КТ ₁	КТ ₂	КТ ₃	КТ ₄	КТ ₅
-12В	-809мВ	-12В	-12В	-75,4мВ